

⑤

Int. Cl. 2:

G 11 C 7/00

⑯ **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

DEUTSCHES



PATENTAMT

DE 28 28 855 A 1

⑪

Offenlegungsschrift 28 28 855

⑫

Aktenzeichen:

P 28 28 855.3-53

⑬

Anmeldetag:

30. 6. 78

⑭

Offenlegungstag:

3. 1. 80

⑳

Unionspriorität:

⑳ ㉑ ㉒

⑤④

Bezeichnung:

Wortweise elektrisch umprogrammierbarer, nichtflüchtiger Speicher

⑦①

Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

⑦②

Erfinder:

Schrenk, Hartmut, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., 8013 Haar

Prüfungsantrag gem. § 28 b PatG ist gestellt

DE 28 28 855 A 1

Patentansprüche

1. Wortweise elektrisch umprogrammierbarer, nichtflüchtiger Speicher mit matrixförmig angeordneten Speicherzellen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix
5 zusammengeschaltet ist, daß für jede Speicherzeile variable Löscho- und Schreibdauern vorgesehen sind, deren Ende durch das Erreichen eines vorgegebenen Löscho- bzw. Schreibzustandes einer oder mehrerer Speicherzellen aus der zu löschenden bzw. zu schreibenden Speicherzeile
10 angezeigt wird, wobei der Löscho- bzw. Schreibzustand einer oder mehrerer Speicherzellen der zu löschenden bzw. zu schreibenden Speicherzeile während der Löscho- bzw. Schreibdauer dieser Speicherzeile kontrolliert wird.
- 15 2. Speicher nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine Ansteuerung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß zur Erreichung einer variablen Löschodauer einer Speicherzeile und zur Kontrolle des Löschozustandes einer oder mehrerer Speicherzellen der zu löschenden Zeile, die an den Speicherzellen anliegenden Löschospannungen in eine zeitliche Folge von Einzelimpulsen aufgeteilt werden, so daß in den Impulspausen jeweils ein Kontrollesevor-
20 gang eingeschaltet wird.
- 25 3. Speicher nach Anspruch 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine Ansteuerung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die Löschodauer einer Speicherzeile beendet ist, wenn alle Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, eine Schwellspannung von U_T aufweisen, wobei $|U_T|$ kleiner
- 30

oder gleich $|U_{GL}|$ ist, wenn U_{GL} einen vorgegebenen Schwellwert der verwendeten Speicherzellen bedeutet.

4. Speicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ansteuerung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die variable Löschdauer mittels einer zeitlich kontinuierlich anliegenden Löschspannung und mittels gleichzeitigem Kontrolllesen erreicht wird, wobei die Löschdauer einer Speicherzeile beendet ist, wenn alle Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, eine Schwellspannung U_T aufweisen, für die die Beziehung $|U_T| \leq |U_{GL}|$ gilt.
5. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß zur Erreichung einer variablen Schreibdauer einer Speicherzeile und zur Kontrolle des Programmierzustandes einer oder mehrerer Speicherzellen der zu programmierenden Speicherzeile, die an den Speicherzellen anliegenden Programmierspannungen in eine zeitliche Folge von Einzelimpulsen aufgeteilt werden, so daß in den Impulspausen jeweils ein Kontrollesevorgang eingeschaltet wird.
6. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die Schreibdauer einer Speicherzeile beendet ist, wenn alle Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, eine Schwellspannung von $|U_T|$ oder gleich $|U_{GS}|$ aufweisen.

7. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß wäh-
rend der Löschdauer und innerhalb eines Kontrollesevor-
gangs bei einer Gatespannung U_{GL} der gelöschte Zustand
5 durch das Absinken des Absolutwertes der Drainspannung
 $|U_D|$ und während der Schreibdauer und innerhalb eines
Kontrollesevorgangs bei einer Gatespannung U_{GS} der pro-
grammierte Zustand durch das Ansteigen der Drainspannung
 $|U_D|$ angezeigt wird.
- 10 8. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß eine
Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusam-
mengeschaltet ist, daß diejenigen Drain-Ausgangssignale,
15 die das Ende einer Schreib- oder Löschdauer einer Spei-
cherzeile anzeigen, zum Abschalten der an der zugehöri-
gen Speicherzeile anliegenden Schreib- bzw. Löschspan-
nung verwendet werden.
- 20 9. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß zum
Aufbau der einzelnen Speicherzelle elektrisch umprogram-
mierbare, nach dem Floating-Gate- oder dem MNOS-Prinzip
aufgebaute Feldeffekttransistoren verwendet werden.
- 25 10. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die
Gateleitungen der zum Aufbau von Speicherzellen verwen-
deten Feldeffekttransistoren wortweise und die zugehö-
30 rigen Drainleitungen bitweise geführt werden.
11. Speicher nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, daß
eine Ansteuerschaltung mit der Speichermatrix zusammen-

- geschaltet ist, daß die Gate-Spannungen, die als vorgegebene Schwellspannungswerte (U_{GS} und U_{GL}) zum Kontrolllesen beim Programmieren und Löschen benötigt werden, sowie die Gatespannung für das Auslesen des Speichers
- 5 (U_{GR}) aus ein und demselben Spannungsteiler entnommen werden, so daß stets $|U_{GL}|$ kleiner als $|U_{GR}|$ und zugleich $|U_{GR}|$ kleiner als $|U_{GS}|$ gilt.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 78 P 1110 BRD

- 5 Wortweise elektrisch umprogrammierbarer, nichtflüchtiger
Speicher.
-

Die Erfindung betrifft einen wortweise elektrisch umpro-
grammierbaren, nichtflüchtigen Speicher mit matrixförmig
10 angeordneten Speicherzellen.

Aus IEEE Transactions on Electron Devices Vol. ED-24,
Nr. 5, Mai 1977, Seiten 606 bis 610 ist eine Floating-
Gate-Speicherzelle zur Herstellung von nichtflüchtigen,
15 elektrisch umprogrammierbaren Speichern bekannt. Bei die-
sen Feldeffekttransistoren ist ein allseitig isoliertes
floatendes Speichergate und ein steuerbares Steuergate
vertikal über der Kanalstrecke angeordnet, wobei das
Steuergate die gesamte Kanalstrecke überdeckt, während
20 das floatende Gate nur einen Teil davon überlagert. Die
sogenannte Splitgate-Struktur vermeidet Fehler beim Aus-
lesen gelöschter Speicherzellen mit Depletioncharakter.
Das Laden des floatenden Speichergates erfolgt mittels
Kanalinjektion. Dazu werden Elektronen in einem kurzen

Kus 1 Lau - 5.5.78 909881/0488

Kanal beschleunigt und mittels eines zusätzlichen elektrischen Querfeldes zum Speichergate befördert. Das Entladen oder Löschen des floatenden Gates erfolgt durch ein Rücktunneln der Elektronen bei einer hohen angelegten elektrischen Spannung zwischen dem Steuergate und einem Diffusionsgebiet.

In der deutschen Patentanmeldung P 27 43 422.6 (VPA 77 P 1147) wird ein wortweise löscher, nichtflüchtiger Speicher in Floating-Gate-Technik vorgeschlagen. Sowohl das Laden als auch das Entladen der floatenden Gates erfolgt mittels eines direkten Übergangs von Elektronen zwischen floatendem Gate und Substrat, wobei ein hohes elektrisches Feld geeigneter Polarität zwischen dem floatenden Gate und dem Substrat angelegt wird.

Als Beispiel für einen Haftstellenspeicher ist aus Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte, Springer-Verlag, Band 4 (1975) Nr. 4 Seiten 213 bis 219 eine MNOS-Speicherzelle zur Herstellung von nichtflüchtigen Speichern bekannt. Eine Ladungsspeicherung erfolgt hierbei durch ein elektrisches Umladen von Haftstellen an der Grenzfläche zwischen einer Nitrid- und einer Oxydschicht. Das Laden wie auch das Entladen der Haftstellen erfolgt mittels Elektronenübergängen durch Tunneln bei großen elektrischen Feldstärken.

Aus IEEE Transaction on Electron Device, Vol. ED-24, Nr.5, Mai 1977, Seiten 584 bis 586, sind Speicherzellen bekannt, die in ähnlicher Weise wie MNOS-Transistoren arbeiten, bei denen jedoch die Schichtenfolge metallische Gate-Elektrode, Nitrid, Oxyd durch Transistoren ersetzt wird, die eine Schichtenfolge Polysilicium, Oxinitrid, Nitrid, Oxyd aufweisen.

Bei allen bisher bekannten Speichern, die aus den angegebenen Speicherzellen aufgebaut sind, wird die Lösch- bzw. Programmierzeit über ein externes Zeitglied fest vorgegeben und eingestellt. Die Lösch- bzw. Programmierzeiten sind dabei so groß zu wählen, daß fertigungstechnisch bedingte Schwankungen der Lösch- und Programmiereigenschaften der einzelnen Zellen nicht nur innerhalb eines Chips, sondern auch hinsichtlich verschiedener Fertigungschargen berücksichtigt werden. Außerdem müssen auch die durch das Zeitglied selbst bedingten Toleranzschwankungen der Zeitdauer einbezogen werden. Hohe Programmier- und Löschzeiten bergen die Gefahr von Nachbarwortstörungen und bedeuten oftmals auch eine Verschlechterung der Programmeigenschaften, insbesondere bei Speicherzellen, bei denen der Schreibvorgang mittels Kanalinjektion erfolgt. Hohe Schreib-Löschzeiten verringern die Zahl der zulässigen Schreib-Löschzyklen. Um zu minimalen Schreib-Lösch-Zeiten zu gelangen und somit die Lebensdauer und die Qualität entsprechender Halbleiterspeicher heraufzusetzen, wäre es wünschenswert, Halbleiterspeicher so auszustatten, daß sich ein externes Zeitglied erübrigt, und bei der Festsetzung der Schreib-Löschdauer nur die Schwankungen innerhalb ein- und desselben Chips Einfluß besitzen, während Schwankungen hinsichtlich verschiedener Halbleiterchargen außer Betracht bleiben. Damit kann eine wesentliche Verringerung der Schreib-Löschzeiten erreicht werden, und die Qualität wie die Lebensdauer der betreffenden Speicher entsprechend heraufgesetzt werden.

30

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen wortweise elektrisch umprogrammierbaren, nichtflüchtigen Speicher so auszustatten, daß sich ein externes Zeitglied erübrigt und die effektiven Programmier- bzw. Schreibzei-

- 8 -

78 P 1110 BRD
VPA

2828855

ten der Einzelzellen gegenüber Speichern mit externen Zeitgliedern herabgesetzt werden.

5 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusammengesaltet ist, daß für jede Speicherzeile variable Löscho- und Schreibdauern vorgesehen sind, deren Ende durch das Erreichen eines vorgegebenen Löscho- bzw. Schreibzustandes einer oder mehrerer Speicherzellen aus
10 der zu löschenden bzw. zu schreibenden Speicherzeile angezeigt wird, wobei der Löscho- bzw. Schreibzustand einer oder mehrerer Speicherzellen der zu löschenden bzw. zu schreibenden Speicherzeile während der Löscho- bzw. Schreibdauer dieser Speicherzeile kontrolliert wird.

15 Der erfindungsgemäße Speicher hat gegenüber den bekannten Speichern den Vorteil, daß das äußere Zeitglied eingespart wird, dadurch wird die Gesamtanordnung zum Betrieb des Speichers einfacher und billiger. Die Toleranzschwankungen aller zu einem Zeitglied gehörenden Bauteile,
20 denen bei der Bestimmung der Zeitkonstante Rechnung getragen werden muß, gehen nicht mehr in die Schreib- bzw. Löschdauer des erfindungsgemäßen Speichers ein und tragen somit auch nicht zu einer Vergrößerung der Schreib- und Löschdauer bei.

Bei der Auslegung eines externen Zeitgliedes sind auch Toleranzschwankungen hinsichtlich der Programmier- bzw. Löschozeiten von Speicherchips aus verschiedenen Fertigungschargen zu beachten. Da in die Programmier- bzw.
30 Löschozeiten des erfindungsgemäßen Speichers maximal die Schwankungen innerhalb eines Halbleiterchips eingehen, verringern sich auch deshalb in vorteilhafter Weise die

909881/0488

Programmier- bzw. Löschzeiten des erfindungsgemäßen Speichers gegenüber herkömmlichen Speichern mit externem Zeitglied.

- 5 Eine Verringerung der Programmier- bzw. Löschzeit eines Speichers ist zum ersten für den Betrieb eines solchen Speichers von Vorteil. Zum zweiten hat eine verkürzte Umprogrammierdauer wiederum Rückwirkungen auf die Lebensdauer der Speicher. Es ist bekannt, daß die Programmier- und Löscheigenschaften eines Speichers sich mit zunehmender Zahl der Schreib-Löschzyklen verschlechtern. Bewirkt werden diese Verschlechterungen z.B. durch die Oxydvergiftungen, welche heiße Ladungsträger bewirken können, oder durch Ermüdungserscheinungen von Nidridschichten. Verkürzte Umprogrammierzeiten bedeuten somit eine erhöhte Zahl von möglichen Schreib-Lösch-Zyklen und eine erhöhte Lebensdauer des erfindungsgemäßen Speichers.

20 Durch Verringerung der Löschzeiten wird außerdem bei Floating-Gate-Speichern die Gefahr eines Überlöschens, d.h. das Verschieben der Schwellspannungen zu stark negativen Werten hin reduziert. Dadurch können wiederum mögliche Schwierigkeiten beim anschließenden Programmiervorgang mittels Kanalinjektion verringert werden.

- 25 Schließlich führt die Verringerung der Umprogrammierdauer eines Speichers auch zu einer geringeren Nachbarwortstörung als das bei längeren Umprogrammierzeiten der Fall ist. Längere Umprogrammierzeiten bewirken in einzelnen Zellen von Nachbarworten oftmals das ungewollte Einschreiben oder Löschen einer Information, was zu Fehlern beim Betrieb von Speichern führt.

35 Eine Verkürzung der Programmier- und Löschzeiten hat weiterhin den Vorteil einer kürzeren Strombelastung und damit einer geringeren Aufheizung des Halbleiterkristalls.

Dieser Vorteil ist für solche Speicher von besonderer Bedeutung, bei denen beim Programmieren oder Löschen erhebliche Ströme fließen, wie z.B. beim Programmieren von Speicherzellen mittels Kanalinjektion.

5

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß eine Ansteuerung derart mit der Speichermatrix zusammengesaltet ist, daß zur Erreichung einer variablen Löschdauer einer Speicherzeile und zur Kontrolle des Lösches-
10 standes einer oder mehrerer Speicherzellen der zu löschen-
den Zeile, die an den Speicherzellen anliegenden Löschspannungen in eine zeitliche Folge von Einzelimpulsen aufgeteilt werden, so daß in den Impulspausen jeweils ein
Kontroll-Lesevorgang eingeschaltet wird.

15

Bei Speicherzellen, die keinen vom Kanalbereich elektrisch isolierten Löschbereich aufweisen, ist ein gleichzeitiges Löschen und Kontrolllesen insofern nicht möglich, als z.B. bei n-Kanal-Speicherzellen zum Löschen eine hohe positive
20 Spannung am Source anliegen muß, während zum Kontrolllesen das Source auf Masse liegen muß. In p-Kanaltechnik gilt Entsprechendes mit vertauschten Vorzeichen der anliegenden Spannungen. Diese beiden Bedingungen sind
gleichzeitig nicht erfüllbar. Ein Aufteilen der Lösch-
25 spannung in eine zeitliche Folge von Einzelimpulsen ermöglicht jedoch ein Kontrolllesen während der Löschimpulspausen. Für die genannte Art von Speicherzellen ist das Aufteilen der Löschspannung in eine zeitliche Folge von Einzelimpulsen von besonderer Bedeutung.

30

Das schließt jedoch nicht aus, daß auch Zellen, die über ein vom Kanalbereich elektrisch isoliertes Löschenfenster verfügen (siehe Patentanmeldung P 26 43 987.2, VPA 76 P 6257) auch mittels einer Folge von Löschimpul-

sen gelöscht werden können, wenn auch für solche Zellen ein Löschen mittels einer zeitlich konstanten Löschspannung möglich ist. Da durch impulsweises Löschen die Kristallaufheizung geringer ist, kann z.B. die Anwendung von Löschimpulsen auch bei Zellen mit isoliertem Löschenfenster von Vorteil sein.

Es ist vorteilhaft, daß eine Ansteuerung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die Löschdauer einer Speicherzeile beendet ist, wenn alle Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, eine Schwellspannung von U_T aufweisen, wobei $|U_T|$ kleiner oder gleich $|U_{GL}|$, wenn U_{GL} einen vorgegebenen Schwellwert der verwendeten Speicherzellen bedeutet.

Diese Bedingung läßt sich z.B. bei Speicherzellen in n-Kanaltechnik wie folgt realisieren:
Eine Speicherzelle ist im ungelöschten Zustand, falls an ihrem Steuergate nicht eine ausreichend hohe positive Spannung angelegt wird, gesperrt. Wird beispielsweise zum Source hin gelöscht, so liegt während der Löschimpulse am Source eine hohe positive Spannung an, während das Steuergate auf Masse liegt. Am Drain ist durch eine geeignete Schaltung stets eine gewisse, nicht sehr hohe positive Spannung vorgegeben, die gerade so groß ist, daß sie zum Auslesen und zum Kontrolllesen der Zellen ausreicht. Zu Beginn des Löschvorganges, solange die Schwellspannung $|U_T|$ größer als der vorgegebene Schwellwert $|U_{GL}|$ ist, bleibt die zu löschende Zelle auch während der Löschimpulspausen gesperrt. Sinkt jedoch die Schwellspannung nach einigen Löschimpulsen soweit ab, daß sie den Wert $|U_{GL}|$ erreicht oder unterschreitet, so ist die Zelle in der nächstfolgenden Impulspause leitend. Da während der Impulspausen das Source der Zellen

auf Masse liegt, das Drain andererseits stets mit einer gewissen positiven Spannung beaufschlagt ist, die zum Lesen und Kontrolllesen ausreicht, fließt durch die Zelle nunmehr ein Strom. Dieser Strom von einer oder mehreren Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, kann wiederum als Signal zur Beendigung der Löschdauer eines angewählten Wortes benutzt werden. Die Speicherzellen werden also nur so lange gelöscht, bis der Zustand "0" gerade mit einem einstellbaren Sicherheitsabstand erreicht ist.

Bei bestimmten Zellen ist es auch vorteilhaft, daß eine Ansteuerung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die variable Löschdauer mittels einer zeitlich kontinuierlich anliegenden Löschspannung und mittels gleichzeitigem Kontrolllesen erreicht wird, wobei die Löschdauer einer Speicherzeile beendet ist, wenn alle Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, eine Schwellspannung U_T aufweisen, für die die Beziehung

$$|U_T| \leq |U_{GL}| \text{ gilt.}$$

Ein kontinuierliches Löschen und gleichzeitiges Lesen ist bei Speicherzellen vom Floating-Gate-Typ durchführbar, die ein vom Kanalbereich elektrisch isoliertes Löschenfenster besitzen, so daß die Source-Spannung auch während der gesamten Löschdauer 0 Volt betragen kann, während das isolierte Diffusionsgebiet im Löschenfenster eine hohe positive Spannung aufweist. Eine solche Zelle ist in der Patentanmeldung P 26 43 987.2 (VPA 76 P 6257) beschrieben..

Es ist auch vorteilhaft, daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß zur Erreichung einer variablen Schreibdauer einer Spei-

cherzeile und zur Kontrolle des Programmierzustandes einer oder mehrerer Speicherzellen der zu programmierenden Speicherzeile, die an den Speicherzellen anliegenden Programmierspannungen in eine zeitliche Folge von Einzelimpulsen aufgeteilt werden, so daß in den Impulspausen jeweils ein Kontrollesevorgang eingeschaltet wird.

Das Aufteilen der Programmierdauer in Einzelimpulse hat insbesondere bei Zellen, die mit Kanalinjektion programmiert werden, den Vorteil, daß ein starkes Aufheizen des Halbleiterchips durch die hohen Kanalströme dadurch verringert wird.

Ein Kontrolllesen an einer zu programmierenden Zelle während der Impulspause hat für alle verwendeten Zellen weiterhin den Vorteil, daß die Programmierdauer einer Zelle der tatsächlich benötigten Programmierzeit dieser Zelle angepaßt werden kann. Damit wird der Schwellwert einer zu programmierenden Zelle nicht wesentlich über einen oberen vorgegebenen Nennwert der Schwellspannung hinaus verschoben. Daraus ergibt sich wiederum der Vorteil einer kürzeren Programmierzeit und folgedessen einer geringeren Schädigung der Halbleiterzellen, was wiederum zu einer erhöhten Lebensdauer und einer erhöhten Anzahl von Schreib-Löschzyklen führt. Schädigungen an erfindungsgemäßen Speichern, die durch das Umprogrammieren zustande kommen, führen nicht, wie bei anderen Speichern, zu möglichen Totalausfällen, sondern vergrößern nur die Schreib-Löschzeiten kontinuierlich.

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die Schreibdauer einer Speicherzeile beendet ist, wenn alle Speicherzellen, an denen kontrollgelesen wird, eine Schwellspannung von $|U_T|$ größer oder gleich $|U_{GS}|$ aufweisen.

- Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß während der Löschdauer und innerhalb eines Kontrollesevorgangs bei einer Gatespannung U_{GL} der gelöschte Zustand durch das Absinken des Absolutwertes der Drainspannung $|U_D|$ und während der Schreibdauer und innerhalb eines Kontrollesevorgangs bei einer Gatespannung U_{GS} der programmierte Zustand durch das Ansteigen der Drainspannung $|U_D|$ angezeigt wird.
- 5
- 10 Es ist vorteilhaft, daß eine Ansteuerschaltung derart mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß diejenigen Drain-Ausgangssignale, die das Ende einer Schreib- oder Löschdauer einer Speicherzeile anzeigen, zum Abschalten der an der zugehörigen Speicherzeile anliegenden Schreib- bzw. Löschspannung verwendet werden.
- 15

Es ist auch erfinderisch, daß zum Aufbau der einzelnen Speicherzellen elektrisch umprogrammierbare, nach dem Floating-Gate- oder dem MNOS-Prinzip aufgebaute Feldeffekttransistoren verwendet werden.

20

Es ist schaltungstechnisch vorteilhaft, daß die Gateleitungen der zum Aufbau von Speicherzellen verwendeten Feldeffekttransistoren wortweise und die zugehörigen Drainleitungen bitweise geführt werden.

25

Es ist vorteilhaft, daß eine Ansteuerschaltung mit der Speichermatrix zusammengeschaltet ist, daß die Gate-Spannungen, die als vorgegebene Schwellspannungswerte (U_{GS} und U_{GL}) zum Kontrolllesen beim Programmieren und Löschen benötigt werden, sowie die Gate-Spannung für das Auslesen des Speichers (U_{GR}) aus ein und demselben Spannungsteiler entnommen werden, so daß stets $|U_{GL}|$ kleiner als $|U_{GR}|$ und zugleich $|U_{GR}|$ kleiner als $|U_{GS}|$ gilt.

30

- Diese Maßnahme garantiert in vorteilhafter Weise einen sicheren Mindestabstand zwischen der Gatespannung U_{GR} beim Auslesen und der Schwellspannung $U_T("1")$ des programmierten Zustandes, wobei gilt $|U_T("1")| > |U_{GR}|$ bzw.
- 5 der Schwellspannung $U_T("0")$ des gelöschten Zustandes einer Speicherzelle, wobei gilt $|U_T("0")| < |U_{GR}|$. Es kann somit immer sicher ausgelesen werden. Toleranzbedingte unterschiedliche Schreib- und Löscheigenschaften der Speicherzelle innerhalb eines Speichers wirken sich
- 10 nicht auf die Zuverlässigkeit beim Auslesen, sondern nur auf die Dauer des Schreib- bzw. Löschvorganges aus. Weil der unprogrammierte und der programmierte Zustand mit dieser Maßnahme relativ zur Auslesespannung sehr genau festgelegt werden kann, läßt sich die Breite des elek-
- 15 trischen Fensters, d.h. der Potentialunterschied zwischen der Gatespannung beim Kontrolllesen während des Schreibens U_{GS} und der Gatespannung beim Kontrolllesen während des Löschsens U_{GL} herabsetzen. Dadurch können in vorteilhafter Weise entweder die Spannungen während des
- 20 Umprogrammierens niedrig sein oder aber die Umprogrammierdauer ist besonders kurz. Weiterhin kann mit dieser Maßnahme das elektrische Fenster in einen vorgegebenen Schwellspannungsbereich hineingelegt werden.
- 25 Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnung und an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Ausführungsbeispiele beziehen sich auf n-Kanaltechnik. Analoge Ausführungsbeispiele sind jedoch auch in p-Kanaltechnik möglich. Es zeigen:
- 30 Fig. 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Speichers;
- Fig. 2a graphische Darstellungen von Lösch-Schreib-, bis 2g Kontrollese- und Ausleseimpulsen;

Fig. 3 zwei Beispiele einer Auswertlogik für erfindungs-
und 3a gemäßige Speicher;

Fig. 4 Gateansteuerschaltung für erfindungsgemäße Spei-
cher und Source- und Drainansteuerung für Speicher
mit Zellen, die mit Kanalinjektion geladen werden;

Fig. 5 Source- und Drainansteuerschaltung für erfindungs-
gemäßige Speicher mit Speicherzellen, die mittels
starker elektrischer Felder zwischen Speichergate
und einem Diffusionsgebiet geladen werden.

10

Fig. 1 stellt ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen
Speichers mit einer Speichermatrix 100 mit m-Zeilen und
n-Spalten dar. An die Speichermatrix 100 ist eine Source-
Drain-Ansteuerung 200 angeschlossen, die die Sourcespan-
nungen U_{S1} bis U_{Sn} und die Drainspannungen U_{D1} bis U_{Dn}
versorgt (angedeutet durch Pfeile zwischen der Speicher-
matrix 100 und Source-Drain-Ansteuerung 200). Die Pfeil-
richtung soll auf die Seite der Verbindungsleitungen hin-
weisen, von der aus die betreffende Spannung festgelegt
wird. Die gegenläufige Pfeilrichtung für U_{D1} bis U_{Dn}
besagt, daß die Drainspannungen entweder direkt über
eine Drainansteuerung oder indirekt bei elektrisch
floatendem Drain auch über die Sourceansteuerung be-
stimmt sind. Die Drainspannungen U_{D1} bis U_{Dn} der Spei-
chermatrix 100 sind andererseits auch an eine Auswertlogik
400 angeschlossen (angedeutet durch Pfeile zwischen der
Speichermatrix 100 und der Auswertlogik 400). Die Ein-
gänge D_{E1} bis D_{En} der Auswertlogik 400 sowie der Source-
und Drainansteuerung 200 sind miteinander elektrisch lei-
tend verbunden. Diese elektrisch leitende Verbindung der
Dateneingänge von Auswertlogik 400 und Source- und Drain-
ansteuerung 200 wurde aus Gründen der besseren Übersicht
nur für den Dateneingang der ersten Spalte D_{E1} in Fig.1
durch die strichpunktierte Linie 1000 angedeutet. Die

- Datenausgänge D_{A1} bis D_{An} , dargestellt durch Pfeile, die aus der Source-Drainansteuerung 200 herausführen, sind durch den Pegel der Drainspannungen U_{D1} bis U_{Dn} festgelegt. Die Gate-Spannungen der wortweise angesteuerten
- 5 Gateleitungen der Speichermatrix 100 werden durch eine Gateansteuerung 500 mit geeigneten Potentialen U_{G1} bis U_{Gm} versorgt. In die Gateansteuerung 500 werden die Auswahlleitungen eines Zeilendekoders W_1 bis W_m geführt, so daß eine geeignete Wortauswahl getroffen werden kann.
- 10 Die Steuerschaltung mit Impulsteil 300 speist über die Leitung 302 die erforderlichen Impulse in die Source- und Drainansteuerung 200 und entsprechend über die Leitung 305 in die Gateansteuerung 500 ein. Leitungen 304 verbinden die Auswertlogik 400 mit der Steuerschaltung
- 15 mit Impulsteil 300, wodurch die Auswertlogik 400 auf die Zeitdauer der Impulsabgabe der Steuerschaltung mit Impulsteil 300 einwirkt.

- In Fig. 2 werden die Impulse für eine Ansteuerung dargestellt, bei der das Löschen und Schreiben der Speicherzellen nicht wie üblich während einer vorgegebenen Zeitdauer, sondern innerhalb vorgegebener Schwellspannungswerte, zwischen dem Schwellspannungswert $U_T("0")$ einer umprogrammierten Zelle und $U_T("1")$ einer programmierten
- 20 Zelle, erfolgt. Löschimpulse nach Fig.2a bewirken eine schrittweise absinkende Schwellspannung 24, dargestellt in Fig.2b, während der Löschimpulsdauer. Die Kontrollleseimpulse während des Löschens fallen in die Löschimpulspausen.

30

Analoges gilt für den Schreibvorgang, wie aus Figuren 2d bis 2f ersichtlich.

In Fig. 2a sind Source-Spannungsimpulse U_S in Abhängig-

- 18 -

VPA 78 P 1110 BRD

- keit von der Zeit t dargestellt. Rechteckimpulse 11, 12, 13 werden zum Zwecke des Löschs dem Source einer angewählten Zelle zugeführt. Die Dauer eines Löschimpulses ist mit T_L bezeichnet. Die Zeitdauer von Beginn eines
- 5 Löschimpulses bis zum Beginn des nächstfolgenden Löschimpulses beträgt T_1 . Die Dauer der Impulspause zwischen zwei aufeinanderfolgenden Löschimpulsen beträgt somit $T_1 - T_L$. In Fig. 2b wird die Änderung der Schwellspannung einer angewählten Zelle während der Löschdauer dieser
- 10 Zelle dargestellt, wobei das Löschen mittels Impulsen nach Fig. 2a erfolgt. Die Schwellspannungskurve 20 einer anfangs ungelöschten Zelle weist zu Beginn des Löschvorganges einen hohen Schwellspannungswert $U_T("1")$ auf. Jeder Löschimpuls bewirkt ein Absinken des Schwellspannungswertes der angewählten zu löschenden Zelle. So
- 15 bewirkt z.B. der Impuls 11 aus Fig. 2a ein Absinken 21 der Schwellspannung U_T , der Impuls 12 ein Absinken 22 und der Impuls 13 ein Absinken 23. Eine angewählte Zelle ist dann gelöscht, wenn ihr Schwellspannungswert
- 20 $U_T("0")$ unterhalb einer anliegenden Gatespannung U_{GL} beim Kontrolllesen während des Löschvorganges liegt. Dieses Kriterium ist für den Endwert 24 der Schwellspannung in der Kurve 20 erfüllt, $U_T("0") < U_{GL}$.
- 25 Fig. 2c stellt die Drainspannungen einer angewählten Speicherzelle während des Löschs dar, an der in den Löschimpulspausen, während einer Zeitdauer T_{KL} , kontrollgelesen wird. Die Drainspannung während der Dauer eines Löschimpulses T_L kann je nach Aufbau und Typ der
- 30 verwendeten Speicherzelle sehr unterschiedliche Werte annehmen. Diese Drainspannungen sind in Fig. 2c der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet. Während der Dauer eines Kontrollesevorganges in der Löschphase T_{KL} liegen die Drainspannungswerte 26, 27, 28 einer an-

-19-

VPA 78 P 1110 BRD

- gewählten Speicherzelle solange auf einem hohen Niveau, bis der Schwellspannungswert der Zelle unter einen gewissen kritischen Wert abgesunken ist. Dieser kritische Wert ist aus Fig. 2b entnehmbar und beträgt U_{GL} , was
- 5 der Gatespannung beim Kontrolllesen während des Löschsens an der zu löschenden Zelle entspricht. Unterschreitet die Schwellspannung der zu löschenden Zelle diesen Wert U_{GL} , so sinkt spontan der Drainspannungswert 29 der zu löschenden Zelle stark ab, d.h. die Zelle wird leitend.
- 10 Dieses spontane Absinken der Drainspannung einer oder mehrerer zu löschenden Zellen eines Speichers kann dazu benutzt werden, den Löschvorgang zu beenden.

- In Fig. 2d sind Gatespannungsimpulse U_G in Abhängig-
- 15 keit von der Zeit t dargestellt. Rechteckimpulse 31, 32, 33 werden dem Gate einer angewählten Zelle zugeführt, um eine Information in diese Zelle einzuschreiben. Die Dauer eines Schreibimpulses beträgt T_S . Die Zeitdauer vom Beginn eines Schreibimpulses bis zum Beginn des
- 20 nächstfolgenden Schreibimpulses beträgt T_2 , die Dauer der Impulspause zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schreibimpulsen beträgt $T_2 - T_S$.

- In Fig. 2e wird die Änderung der Schwellspannung einer
- 25 angewählten Zelle während der Schreibdauer dieser Zelle dargestellt, wobei das Schreiben mittels Impulsen nach Fig. 2d erfolgt. Die Schwellspannungskurve 40 einer anfangs gelöschten Zelle weist zu Beginn des Schreibvorganges einen niedrigen Schwellspannungswert 39, den
- 30 Schwellspannungswert U_T ("0") einer unprogrammierten Zelle auf. Jeder Schreibimpuls bewirkt eine Erhöhung des Schwellspannungswertes der einzuschreibenden Zelle. So bewirkt der Impuls 31 aus Fig. 2d einen Anstieg 41 der Schwellspannung U_T , der Impuls 32 einen Anstieg 42 und
- 35 der Impuls 33 einen Anstieg 43. Der Schreibvorgang ist dann beendet, wenn der Schwellspannungswert einer an-

809881/0488

ORIGINAL INSPECTED

gewählten Zelle oberhalb einer gewissen, beim Kontrolllesen anliegenden Gatespannung U_{GS} liegt. Dieses Kriterium ist für den Endwert 44 der Schwellspannung U_T , den Wert $U_T("1")$, in der Kurve 40 erfüllt, $U_T("1") > U_{GS}$.

5

Fig. 2f stellt die Drainspannung U_D während des Schreibvorganges einer angewählten Speicherzelle dar, bei der in den Schreibimpulspausen während einer Zeitdauer T_{KS} kontrollgelesen wird. Wie in Fig. 2c ist auch in Fig. 2f nur die Drainspannung während der Dauer des Kontrollvorgangs in der Schreibphase T_{KS} , nicht aber während der Dauer der Schreibimpulse T_S eingezeichnet. Die Drainspannungswerte 46, 47, 48 einer angewählten Speicherzelle liegen während des Schreibvorganges solange auf einem niedrigen Niveau, d.h. die angewählte Zelle ist durchgeschaltet, bis der Schwellspannungswert der Zelle über einen gewissen kritischen Wert angestiegen ist. Dieser kritische Wert ist aus Fig. 2e entnehmbar und beträgt U_{GS} , was der Gatespannung beim Kontrolllesen während des Schreibens an der angewählten Zelle entspricht. Überschreitet die Schwellspannung der angewählten Zelle diesen Wert U_{GS} , so steigt spontan der Drainspannungswert 49 der angewählten Zelle stark an, d.h. die Zelle führt keinen Strom mehr. Dieses spontane Ansteigen der Drainspannung einer angewählten Zelle eines Speichers kann dazu benutzt werden, den Schreibvorgang zu beenden.

25

Fig. 2g stellt die Gatespannung U_G in Abhängigkeit von der Zeit t einer angewählten Speicherzelle während des Auslesevorgangs dar. Die Rechteckimpulse 51, 52 weisen jeweils das gleiche Potentialniveau, und zwar die Gate-Auslesespannung U_{GR} auf. Diese liegt zwischen der Schwellspannung $U_T("1")$ einer mit einer "1" eingeschriebenen Speicherzelle und der Schwellspannung $U_T("0")$ einer mit einer "0" eingeschriebenen Speicherzelle. In

35

Fig. 4 wird u.a. näher erläutert, wie ein ausreichend
sicherer Abstand zwischen der Auslesespannung U_{GR} und
der Schwellspannung $U_T("1")$ einer aufgeladenen Zelle
einerseits und der Schwellspannung $U_T("0")$ einer gelösch-
5 ten Speicherzelle schaltungsmäßig sicher eingehalten wer-
den kann.

In Fig. 2 ist das Einschreiben und Löschen von Informa-
tionen in angewählte Zellen mittels dargestellten Schreib-
10 bzw. Löschimpulsen verwirklicht. Bei speziell ausgestal-
teten Speicherzellen, wie sie in der Patentanmeldung P
26 43 9872 beschrieben sind, bei denen der Ladungsüber-
gang bei einem Floating-Gate-Speicher außerhalb des Kanal-
bereichs in einem elektrisch isolierten Löschbereich
15 oder Löschfenster stattfindet, können der Löschvorgang
und das Kontrolllesen gleichzeitig ablaufen. Für dieses
Ausführungsbeispiel ist also auch ein statisches Löschen
möglich. Auch in diesem Fall wird die Löschspannung mit-
tels einer geeigneten Auswertlogik und einer Steuerschal-
20 tung in dem Moment abgeschaltet, in dem die Schwellspan-
nung der zu löschenden Zelle einen vorgegebenen unteren
Schwellspannungswert unterschreitet.

Die Symbole T_S bzw. T_L an verschiedenen Anschlüssen der
25 Fig. 3, 4 und 5 deuten an, daß während der Schreibimpuls-
dauer bzw. während der Löschimpulsdauer an diesem An-
schluß eine hinreichend hohe positive Spannung, d.h.
eine "1" am entsprechenden Schaltsymbol anliegt. Ana-
loges gilt für T_{KL} bzw. T_{KS} für die Dauer eines Kon-
30 trollesevorgangs während der Lösch- bzw. Schreibimpuls-
pausen. Die Worte Schreiben, Löschen, Lesen bedeuten,
daß entsprechende positive Spannungen während der ge-
samten Schreib-, Lösch- bzw. Lesedauer an den entspre-
chenden Anschlüssen anliegen. Die Worte Löschen bzw.

Schreibende deuten die Abgabe eines Spannungssignals zum Zeitpunkt des Lösches bzw. Schreibendes an.

Fig. 3 stellt zwei Beispiele einer Auswertlogik 400 für
 5 erfindungsgemäße Speicher dar. Bei dem logischen Schalt-
 bild 410 aus Fig. 3 werden alle bitweise geschalteten
 Drainleitungen 1 bis n aus der Speichermatrix 100 heraus-
 geleitet. Die bitweise geschalteten Drainleitungen 1 bis
 n werden einerseits über je einen Inverter α_1 bis α_n
 10 auf ein UND-Glied β geführt und andererseits über je ein
 ODER-Glied δ_1 bis δ_n auf ein UND-Glied γ geleitet. Zusätz-
 lich sind die Dateneingänge D_{E1} bis D_{En} über je einen In-
 verter η_1 bis η_n auf die entsprechenden ODER-Glieder
 δ_1 bis δ_n gelegt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
 15 sind nur die 1., die 2. und die n-te Drainleitung mit
 zugehörigen Schaltsymbolen dargestellt. Es ist dafür ge-
 sorgt, daß das UND-Glied β nur während der Dauer der Kon-
 trollesevorgänge in der Löschpause, d.h. während der
 Zeit T_{KL} , freigegeben ist, was z.B. durch einen weiteren
 20 Anschluß 420 am UND-Glied β erfolgen kann, der während
 der Dauer des Kontrolllesens beim Löschen jeweils eine po-
 sitive Spannung führt und somit eine "1" ans UND-Glied β
 legt, während er zu den übrigen Zeiten keine Spannung
 führt und somit eine "0" an das UND-Glied β legt. Ein
 25 Anschluß 430 sorgt analog dafür, daß das UND-Glied γ
 nur während der Dauer T_{KS} der Kontrollesevorgänge in der
 Schreibphase freigegeben ist. An den Anschluß 430 werden
 deshalb Spannungsimpulse angelegt, die während der Dauer
 T_{KS} eine positive Spannung führen und somit eine "1" an
 30 das UND-Glied γ legen, während sie in den zugehörigen
 Kontrollesepasen eine "0" an das UND-Glied γ legen und
 es somit während dieser Zeit nicht freigegeben. Während der
 Dauer T_{KL} des Kontrolllesens in der Löschphase liefert
 zunächst der Anschluß 420 eine "1" an das UND-Glied β .
 35 Während des Löschvorganges eines angewählten Wortes lie-

fern jeweils diejenigen Speicherzellen ihren zugehörigen bitweise geschalteten Drainleitungen i ($i = 1 \dots n$) dann eine "0", wenn ihre Schwellwerte nach Fig. 2b einen vorgegebenen unteren Spannungswert U_{GL} unterschritten haben.

- 5 Nach Erreichen dieses Zustandes an allen Zellen des angewählten Wortes, liefern alle Drainleitungen 1 bis n somit eine "0". Über die zugehörigen Inverter α_1 bis α_n liegt somit an jedem Eingang des UND-Gliedes β eine 1 an und es erscheint somit am Ausgang des UND-Gliedes β das Steuersignal Löschiende, das dann an die Steuerschaltung mit Impulsteil 300 aus Fig. 1 als Spannungsimpuls weitergegeben wird, wodurch wiederum eine weitere Impuls-
10 gabe der Steuerschaltung 300 an die Ansteuerung 200 unterbrochen wird. Der Löschiende ist damit für das angewählte Wort beendet.
15

- Beim Schreiben eines angewählten Wortes werden die 1 bis n bitweise geschalteten Drainleitungen über je ein ODER-Glied \mathcal{J}_1 bis \mathcal{J}_n an ein gemeinsames UND-Glied \mathcal{J} angeschlossen. Den ODER-Gliedern \mathcal{J}_i ($i = 1$ bis n) wird außer
20 der zugehörigen Drainleitung i ($i = 1$ bis n) ebenfalls der zugehörige Dateneingang D_{Ei} ($i = 1$ bis n) über jeweils einen weiteren Inverter \mathcal{N}_i ($i = 1$ bis n) zugeführt. Wird die Zelle i mit einer Information versehen,
25 so führt die i -te bitweise geschaltete Drainleitung nach beendeter Aufladung der entsprechenden Zelle eine hinreichend große positive Drainspannung, d.h. eine "1" dem ODER-Glied \mathcal{J}_i zu. Der zweite Eingang des ODER-Gliedes \mathcal{J}_i wird hingegen mit einer "0" beschickt, da der zugehörige Dateneingang D_{Ei} eine "1" aufweist, die durch
30 den zwischengeschalteten Inverter \mathcal{N}_i in eine "0" umgewandelt wird, die dann den zweiten Eingang des ODER-Gliedes \mathcal{J}_i erreicht. Der Ausgang des ODER-Gliedes \mathcal{J}_i gibt somit an das UND-Glied \mathcal{J} eine "1" ab. Eine zweite

- Speicherzelle, in welche eine "0" eingeschrieben wird, gibt über seine bitweise geschaltete Drainleitung j an das zugehörige ODER-Glied \mathcal{J}_j stets eine Information "0" ab, da die Drainspannung dieser Zelle nicht ansteigt.
- 5 Der entsprechende Dateneingang D_{Ej} führt eine "0" an den Inverter \mathcal{N}_j , der wiederum eine "1" an den zweiten Eingang des ODER-Gliedes \mathcal{J}_j liefert. Der Ausgang des ODER-Gliedes \mathcal{J}_j gibt somit ebenfalls eine "1" an das UND-Glied \mathcal{J} ab. Alle Zellen des angewählten Wortes, in die
- 10 eine "0" eingeschrieben wird, liefern somit von Beginn des Schreibvorganges an eine "1" an den zugehörigen Eingang des UND-Gliedes \mathcal{J} . Alle übrigen Speicherzellen des angewählten Wortes, in welche eine "1" eingeschrieben wird, liefern dann eine "1" an den Eingang des UND-
- 15 Gliedes \mathcal{J} , wenn der Einschreibvorgang in der entsprechenden Zelle beendet ist. Ein weiterer Anschluß 430 am Eingang des UND-Gliedes \mathcal{J} liefert während der Dauer jedes Kontrollesevorganges in der Schreibphase, d.h. während T_{KS} , eine "1" an den Eingang des UND-Gliedes \mathcal{J} .
- 20 Damit wird sichergestellt, daß nur in den Schreibimpulspausen kontrollgelesen wird. Nach Beendigung des Schreibvorganges der langsamsten angewählten Speicherzelle, in welche eine Information eingeschrieben wird, weisen alle Eingänge des UND-Gliedes \mathcal{J} eine "1" auf.
- 25 Das Schreibende wird somit durch eine "1" als Ausgangssignal des UND-Gliedes \mathcal{J} angezeigt. Dieses Ausgangssignal wird aus der Auswertlogik 400 über eine Leitung 304 in die Steuerschaltung mit Impulsteil 300 geleitet (vgl. Fig. 1) und bewirkt dort eine Beendigung der Abgabe
- 30 von Schreibimpulsen an die Gateansteuerung 500. Der Schreibvorgang ist damit beendet.

Bei Integration in MOS-Technik werden anstelle der UND-Glieder \mathcal{B} bzw. \mathcal{J} mit Vorteil auch NOR-Glieder verwendet, wobei die davor geschaltete Logik sinngemäß zu ändern ist.

35

Das logische Schaltbild 450 aus Fig. 3a ist eine vereinfachte Ausführung der mit dem logischen Schaltbild 410 dargestellten Auswertlogik. Hierbei wird eine einzige Meßzelle 451 neben den übrigen Zellen einer Speicherma-

5 trix auf einem Chip angebracht. Das Schreib- bzw. Löschverhalten dieser Meßzelle 451 wird repräsentativ für das Schreib- bzw. Löschverhalten sämtlicher Zellen am Chip angesehen. Das Ende der Schreibdauer oder der Löschdauer der Meßzelle 451 signalisiert zugleich das Schreib- bzw.

10 Löschen aller Zellen eines angewählten Wortes. Die Meßzelle 451 wird während eines Schreib- oder Löschvorganges mit den gleichen Schreib- bzw. Löschimpulsen gespeist wie entsprechende Zellen eines angewählten Speicherwortes. In den Impulspausen wird jedoch nur an der Meßzelle 451 kontrollgelesen. Dazu wird die Drainleitung 452 aus der Meß-

15 zelle 451 herausgeführt und einerseits über einen Inverter α an den Anschluß 453 eines UND-Gliedes β geleitet, und andererseits an einen Anschluß 455 eines UND-Gliedes γ geleitet. Das UND-Glied β enthält außerdem einen Anschluß 454, der in den Löschimpulspausen während der

20 Kontrollsedauer T_{KL} eine "1" dem UND-Glied β zuführt, während er in der übrigen Zeit dem UND-Glied β eine "0" zuführt. Das UND-Glied γ enthält analog einen Anschluß 456, der diesem während der Dauer des Kontroll-

25 lesens in den Schreibimpulspausen eine "1" zuführt, zu allen übrigen Zeiten hingegen eine "0" zuführt. Werden der Meßzelle 451 Löschimpulse zugeführt, so sinkt deren Schwellwert laufend ab. Unterhalb eines gewissen Grenzwertes wird die Meßzelle 451 leitend, d.h. beim Kontroll-

30 lesen gibt die Drainleitung 452 eine "0" an den Inverter α ab, und dieser wiederum eine "1" an den Anschluß 453 des UND-Gliedes β ab. Da der Anschluß 454 während der Kontrollsedauer T_{KL} während der Löschimpulspausen ebenfalls eine "1" führt, gibt das UND-Glied β als Aus-

- gangssignal ebenfalls eine "1" ab, wodurch das Löschiende signalisiert wird. Leitet man in diesem Fall den Ausgang des UND-Gliedes β über die Leitung 304 in die Steuerschaltung mit Impulsteil 300 (vgl. Fig. 1), so kann da-
- 5 mit die Impulsgabe der Steuerschaltung 300 an die Ansteuerung 200 abgeschaltet werden. Das Löschiende der Meßzelle 451 bewirkt somit das Löschiende der angewählten Speicherzellen. Wird andererseits die Meßzelle 451 gleichzeitig mit angewählten Zellen der Speichermatrix mit
- 10 Schreibimpulsen beschickt, so steigt die Schwellspannung der Meßzelle 451 an (vgl. Fig. 2e). Überschreitet die Schwellspannung einen gewissen vorgegebenen Wert, so steigt die Drainspannung in den Impulspausen stark an. Die Drainleitung 452 legt somit an den Anschluß 455 des
- 15 UND-Gliedes γ eine "1". Während der Leseimpulsdauer T_{KS} in den Schreibimpulspausen liegt andererseits auch an dem Anschluß 456 des UND-Gliedes γ eine "1" an. Der Ausgang des UND-Gliedes γ gibt somit eine "1" über die Leitung 304 an die Steuerschaltung mit Impulsteil 300 (vgl. Fig. 1)
- 20 ab, wodurch eine weitere Abgabe von Schreibimpulsen der Steuerschaltung mit Impulsteil 300 an die Gateansteuerung 500 abgeschaltet wird. Die Schreibdauer aller angewählten Zellen der Speichermatrix 100 ist somit gleichzeitig mit der Schreibdauer der Meßzelle 451 beendet. Die Verwen-
- 25 dung einer einzigen Meßzelle ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die toleranzbedingten Schwankungen der Löschi- und Programmieigenschaften aller Speichertransistoren innerhalb eines Speichers hinreichend gering sind.
- 30 Anstelle einer einzigen Meßzelle läßt sich auch eine Spalte von Speicherzellen mit einer bitweise geschalteten Drainleitung verwenden. Jedes angewählte Wort einer Speichermatrix verfügt dann über eine gesonderte Meßzelle, die jeweils analog der Schaltung der Meßzelle 451

das Schreib- und Lösche alle Zellen eines angewählten Wortes signalisiert.

In Fig. 4 ist eine Gate-, Drain- und Sourceansteuerung
5 für eine Speichermatrix 100 dargestellt, die aus Floating-
Gate-Speicherzellen mit Splitgate-Struktur 101 aufgebaut
ist. Die Speicherzellen werden, wie eingangs beschrieben,
mittels Kanalinjektion geladen, während das Entladen des
10 floatenden Gates einer Speicherzelle bei einer angeleg-
ten hohen elektrischen Spannung zwischen dem Steuergate
und einem Diffusionsgebiet mittels rücktunnelnder Elek-
troden aus dem floatenden Gate in das Diffusionsgebiet
erfolgt. Die dargestellte Gateansteuerung 500 ist so
15 eingerichtet, daß die Dauer eines Kontrollesevorgangs
in der Löschimpulspause T_{KL} gerade die gesamte Impuls-
pause zwischen zwei aufeinanderfolgenden Löschimpulsen
ausfüllt, d.h. daß T_{KL} gleich ist der Differenz $T_1 - T_L$
(vgl. Fig. 2a und 2c). Entsprechendes gilt für die Dauer
eines Kontrollesevorgangs in den Schreibphasen T_{KS} in
20 Bezug auf die zugehörigen Schreibimpulspausen. Diese
Wahl der Kontrollesedauer beim Schreibvorgang wie beim
Löschvorgang ist durchaus nicht zwingend. Es muß ledig-
lich sichergestellt sein, daß das Kontrolllesen jeweils
innerhalb der Schreib- bzw. Löschimpulspausen erfolgt,
25 d.h.

$$T_{KL} \leq T_1 - T_L \quad \text{bzw.} \quad T_{KS} \leq T_2 - T_S.$$

In Fig. 4 wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit die
Gateansteuerung der 1., der i-ten und der m-ten Zeile
30 sowie die Source- und Drainansteuerung der 1., der i-ten
und der n-ten Spalte eingezeichnet. Die Ansteuerung der
übrigen Zeilen und Spalten erfolgt analog.

Die Gatespannung U_{Gi} am i-ten ($i = 1$ bis m) Speicherga-
35 te der Speichermatrix 100 wird mittels einer Auswahl-

- logik 501_i entweder über den Transistor 500_{i2} an die Spannung des Punktes 515 gelegt oder mittels des Inverters 500_{i3} über den Transistor 500_{i1} an einen Spannungsteiler 550 angeschlossen. Die Auswahllogik 501_i setzt sich aus
- 5 einem NOR-Glied 503_i zusammen, dessen Ausgang an die Gates der Transistoren 500_{i2} bzw. durch Zwischenschaltungen eines Inverters 500_{i3} an das Gate des Transistors 500_{i1} gelegt ist. Das NOR-Glied 503_i weist zwei Eingänge auf, die ihrerseits mit den Ausgängen zweier UND-Glieder
- 10 502_i und 504_i verbunden sind. Die UND-Glieder 502_i und 504_i besitzen je zwei Eingänge, wobei ein Eingang des UND-Gliedes 502_i durch einen Inverter 505_i mit einem Eingang des UND-Gliedes 504_i verbunden ist.
- 15 Im folgenden soll gezeigt werden, wie die Gate-Ansteuerung 500 alle möglichen Bedingungen für das Löschen, Schreiben, Kontrolllesen und Auslesen verwirklicht. Von einem Zeilen-dekoder ausgehende Auswahlleitungen W_1 bis W_m ermöglichen es, jeweils ein Speicherwort anzuwählen. Im folgenden
- 20 soll stets das Wort i als angewähltes Wort betrachtet werden. Alle übrigen Worte sollen nicht angewählt sein. Nichtangewählte Worte W_k ($k = 1$ bis m ; $k \neq i$) führen über die Leitung 507_k eine Null an das UND-Glied 502_k . Daher weist auch der Ausgang von 502_k eine "0"
- 25 auf. Das UND-Glied 504_k weist infolge des Inverters 505_k am Anschluß 508_k eine "1" auf. Während des gesamten Löschvorganges weist der Eingang 516 des ODER-Gliedes 514 eine "1" auf, weshalb auch der Ausgang des ODER-Gliedes 514 eine "1" an den Eingang 509_k des UND-Gliedes
- 30 504_k legt. Der Ausgang des UND-Gliedes 504_k gibt somit eine "1" an das ODER-Glied 503_k ab, weshalb dessen Ausgang wiederum eine "1" abgibt. Damit wird über den Inverter 500_{k3} und den Transistor 500_{k1} der Spannungsteiler 550 abgeschaltet, während über den Transistor 500_{k2}
- 35 die Gate-Spannung U_{Gk} an die Spannung des Punktes 515

angeschlossen ist. Während der Dauer der Löschimpulse führt der Eingang 521 des NOR-Gliedes 523 eine "1", weshalb der Ausgang von 523 eine "0" führt. Damit ist der Transistor 520 gesperrt und die Gate-Spannung der k-ten

5 Zeile U_{Gk} hat die Spannung des Punktes 515. Bei zu vernachlässigendem Widerstand 510 gilt:

$U_{Gk} \approx U_G \approx 25$ Volt. In den Löschimpulspausen weisen hingegen beide Eingänge des NOR-Gliedes 523 eine "0" auf, weshalb sein Ausgang eine "1" abgibt. Der Transistor 520

10 ist damit durchgeschaltet und die Spannung des Punktes 515, die zugleich ungefähr die Spannung U_{Gk} ist, weist einen Wert von ungefähr 0 Volt auf.

Für ein angewähltes Wort i erhält die Leitung 507_i über

15 die Auswahlleitung W_i eines zugehörigen Zeilendekoders eine "1". Der Eingang 506_i des UND-Gliedes 502_i weist während der gesamten Löschphase sicherlich eine "0" auf, da der Ausgang des UND-Gliedes 511 während des gesamten Löschvorganges stets eine "0" liefert, da wiederum der

20 Eingang 531 nur während der Schreibphase eine "1" und zu anderen Zeiten stets eine "0" liefert. Der Ausgang des UND-Gliedes 502_i gibt somit an den Eingang des ODER-Gliedes 503_i eine "0" ab. Das UND-Glied 504_i legt ebenfalls an den zweiten Eingang des ODER-Gliedes 503_i eine

25 "0", da die "1" am Eingang 507_i durch den Inverter 505_i in eine "0" am Eingang 508_i umgewandelt wird. Der Ausgang des ODER-Gliedes 503_i gibt somit eine "0" ab, weshalb der Transistor 500_{i2} gesperrt wird, während der Transistor 500_{i1} mittels des Inverters 500_{i3} geöffnet

30 wird, so daß die Gatespannung U_{Gi} an den Spannungsteiler 550 angeschlossen ist. Am Ausgang 551 des Spannungsteilers 550 liegt während der Löschimpulse, da während der Löschimpulse der Transistor 567 durchgeschaltet ist, ungefähr eine Spannung von 0 Volt an, die somit

auch als Gatespannung U_{Gi} anliegt. Während der Impulspausen beim Löschen ist der Transistor 567 gesperrt. Die Transistoren 566 und 565 sind während der gesamten Löschdauer ohnehin gesperrt. Damit liegt am Ausgang 551 des Spannungsteilers in den Löschimpulspausen über den durchgeschalteten Transistor 564 die Spannung U_{GL} an, die zugleich auch die Gatespannung U_{Gi} liefert. Mit dieser Spannung U_{GL} am Gate des angewählten Wortes i wird in den Impulspausen kontrollgelesen.

10 Während des Gesamtschreibvorganges führt der Eingang 507_k für ein nicht angewähltes Wort stets eine "0". Damit gibt auch das UND-Glied 502_k eine "0" an einen Eingang des ODER-Gliedes 503_k ab. Das UND-Glied 504_k gibt hingegen

15 eine "1" in den Schreibimpulspausen an den zweiten Eingang des ODER-Gliedes 503_k ab, da der Eingang 508_k des UND-Gliedes 504_k durch den Inverter 505_k stets eine "1" erbringt, und der Eingang 509_k in den Schreibimpulspausen ebenfalls eine "1" bringt. In den Schreibimpulspausen

20 gibt nämlich der Inverter 512 eine "1" an den Eingang 533 des UND-Gliedes 513 ab. An dem zweiten Eingang 532 des UND-Gliedes 513 liegt während des gesamten Schreibvorganges eine "1" an. Somit gibt das UND-Glied 513 eine "1" an den Eingang 517 des ODER-Gliedes 514 ab, was wiederum eine "1" am Ausgang des ODER-Gliedes 514 und damit eine "1" am Eingang 509_k des UND-Gliedes 504_k bewirkt. Während der Schreibimpulse liegt hingegen am Eingang 509_k des UND-Gliedes 504_k eine "0" an, so daß beide Eingänge des ODER-Gliedes 503_k eine "0" aufweisen und

30 somit auch der Ausgang des ODER-Gliedes 503_k während der Schreibimpulse eine "0" aufweisen. Damit sind während der Schreibimpulse die Gateleitungen nicht angewählter Worte wegen des Inverters 500_{k3} über den Transistor 500_{k1} mit dem Spannungsteiler 550 verbunden, während

35 die Gateleitungen nicht angewählter Worte in den

Schreibimpulspausen über den Transistor 500_{k2} auf der Spannung des Punktes 515 liegen. In den Schreibimpulspausen ist der Transistor 520 durchgeschaltet, da das NOR-Glied 523 am Ausgang eine "1" liefert, weil seine beiden

5 Eingänge eine "0" aufweisen. Die Gatespannung U_{Gk} nicht angewählter Worte beträgt in den Impulspausen deshalb ungefähr gleich "0" V. Während der Schreibimpulse hingegen sind die Gates der nicht angewählten Worte infolge der "0" am Ausgang des ODER-Gliedes 503_k und des Inverters 500_{k3}

10 über den Transistor 500_{k1} mit dem Ausgang 551 des Spannungsteilers 550 verbunden. Am Ausgang 551 liegt während der gesamten Schreibphase über den durchgeschalteten Transistor 566 nur die relativ niedrige Spannung U_{GS} an, d.h. die Gatespannung beim Kontrolllesen während des

15 Schreibens. Die Transistoren 564, 565 und 567 des Spannungsteilers 550 sind während der gesamten Schreibphase gesperrt.

Bei einem angewählten Wort i wird die am Eingang 507_i

20 anliegende "1" über den Inverter 505_i in eine "0" an den Anschluß 508_i des UND-Gliedes 504_i invertiert, so daß das UND-Glied 504_i eine "0" an das ODER-Glied 503_i abgibt. Über den Eingang 531 erhält das UND-Glied 511 während der gesamten Schreibphase eine "1". Über den

25 Eingang 530 erhält das UND-Glied 511 eine weitere "1" während der Dauer der Schreibimpulse und eine "0" während der Schreibimpulspausen. Damit gibt das UND-Glied 511 während der Dauer der Schreibimpulse eine "1" und während der Dauer der Schreibimpulspausen eine "0" an

30 den Eingang 506_i des UND-Gliedes 502_i ab. Nachdem der Eingang 507_i des UND-Gliedes 502_i als angewähltes Wort stets eine "1" hat, gibt somit das UND-Glied 502_i während der Dauer der Schreibimpulse eine "1" und während der Dauer der Schreibimpulspausen eine "0" an den Ein-

35 gang des ODER-Gliedes 503_i ab. Der zweite Eingang dieses

ODER-Gliedes weist, wie gezeigt wurde, während der
 Schreibdauer stets eine "0" auf. Während der Dauer der
 Schreibimpulse liegt somit am Ausgang des ODER-Gliedes 503_i
 eine "1" an, weshalb die Gatespannung U_{Gi} über den Tran-
 sistor 500_{i2} am Punkt 515 anliegt. Da während der Schreib-
 impulsdauer der Eingang 522 des NOR-Gliedes 523 eine "1"
 führt, weist sein Ausgang eine "0" auf, weshalb der
 Transistor 520 gesperrt ist. Am Punkte 515 liegt somit
 eine Spannung von ungefähr 25 V an, was der Gatespannung
 U_{Gi} entspricht. Während der Schreibimpulspausen liegt
 hingegen das Gate eines angewählten Wortes i über den
 durchgeschalteten Transistor 500_{i1} am Spannungsteiler
 550 an, an dessen Ausgang 551 infolge des durchgeschal-
 teten Transistors 566 die Spannung U_{GS} , die Gatespannung
 beim Kontrolllesen während des Schreibens anliegt. Alle
 übrigen Transistoren, Transistoren 565, 564 und 567
 sind während der Schreibimpulspausen gesperrt.

Während des Auslesens eines angewählten Wortes i führt
 der Anschluß 506_i des UND-Gliedes 502_i stets eine "0",
 da die Eingänge 530 und 531 des UND-Gliedes 511 stets
 eine "0" aufweisen, weshalb auch der Ausgang des UND-
 Gliedes 511 und somit der Eingang 506_i des UND-Gliedes
 502_i stets eine "0" aufweist.

25

Das UND-Glied 502_i führt somit dem ODER-Glied 503_i
 stets eine "0" zu. Durch den Inverter 505_i erhält der
 Eingang 508_i des UND-Gliedes 504_i stets eine "0", wes-
 halb sein Ausgang dem ODER-Glied 503_i ebenfalls stets
 eine "0" zuführt. Damit führt für die gesamte Auslese-
 phase der Ausgang des ODER-Gliedes 503_i stets eine "0",
 d.h. der Transistor 500_{i2} ist stets gesperrt, während
 der Transistor 500_{i1} infolge des Inverters 500_{i3} lei-
 tend ist und somit die angewählte Gateleitung mit dem

-33-

VPA 78 P 1110 BRD

Spannungsteiler 550 verbindet. Im Spannungsteiler 550 sind während der Auslesephase die Transistoren 567, 564 und 566 gesperrt. Am Ausgang 551 des Spannungsteilers 550 liegt somit die Gate-Auslesespannung U_{GR} an.

5

Im Falle eines nicht angewählten Wortes k liegt der Eingang 508_k des UND-Gliedes 504_k infolge des Inverters 505_k auf "1", der zweite Anschluß 509_k dieses UND-Gliedes führt ebenfalls eine "1", da der Ausgang des ODER-Gliedes 514 infolge einer "1" am Eingang 518 ebenfalls eine "1" führt. Das ODER-Glied 503_k weist somit für nicht angewählte Worte stets eine "1" am Ausgang auf, weshalb der Spannungsteiler 550 von der zugehörigen Gateleitung abgetrennt ist, während an die zugehörige Gateleitung über den Transistor 500_{k2} die Spannung des Punktes 515 angelegt ist. Nachdem beide Eingänge 521 und 522 des NOR-Gliedes 523 je eine "0" führen, ergibt sich am Ausgang dieses NOR-Gliedes eine "1". Der Transistor 520 ist somit durchgeschaltet. Die Spannung des Punktes 515 und damit auch die Spannung der nicht angewählten Gates beträgt somit ungefähr "0" V während der gesamten Auslesedauer.

Die Widerstände 571, 572, 573, 574 des Spannungsteilers 550 können entweder diffundierte Widerstände sein oder Feldeffekttransistoren vom Enhancementstyp im gesättigten oder ungesättigten Zustand, oder aber sie können Feldeffekttransistoren vom Depletionstyp sein. Der Anschluß des Widerstandes 571, der nicht mit dem Widerstand 572 verbunden ist, ist geerdet. Der Anschluß des Widerstandes 574, der nicht mit dem Widerstand 573 verbunden ist, ist an eine Versorgungsspannung angeschlossen, welche größer ist als U_{GL} , die Gatespannung beim Kontrolllesen während des Löschens. Die Spannungsdifferenz $U_{GS} - U_{GL}$, das sogenannte Schreib-Lesefenster, hängt in seiner Dimensionierung von der verwendeten Speichertechnologie ab. Bei

den häufigst verwendeten Speichertypen beträgt das Schreib-Lesefenster etwa 1 V bis 6 V. Die Verwendung eines Spannungsteilers wie in Fig. 4 dargestellt, garantiert sichere Abstände zwischen den verwendeten Kontrollspannungen sowohl beim Schreiben als auch beim Löschen und der Auslesespannung, so daß eine unprogrammierte Zelle sicher von einer programmierten Zelle unterschieden werden kann. Die relative Lage der Spannungen zueinander ist durch einen solchen Spannungsteiler sichergestellt. Toleranzbedingte unterschiedliche Schreib- und Löscheigenschaften der Speicherzellen innerhalb eines Speichers wirken sich nicht auf die Zuverlässigkeit beim Auslesen, sondern nur auf die Dauer des Schreib- bzw. Löschvorganges aus. Die Breite des elektrischen Fensters $U_{GS} - U_{GL}$ kann, dank des Spannungsteilers 550, relativ klein gehalten werden, da die Zustände "0" und "1" relativ zur Auslesespannung sehr genau festgelegt sind. Dadurch dürfen entweder die Spannungen während des Programmierens niedrig sein oder die Umprogrammierung läuft besonders schnell ab. Weiterhin kann durch Verwendung des Spannungsteilers 550 das elektrische Fenster in einem bestimmten gewünschten Schwellspannungsbereich der verwendeten Speicherzellen hineingeschoben werden.

In Fig. 4 ist außerdem die Source-Drain-Ansteuerung 200 dargestellt für eine Split-Gate-Speicherzelle, die mit Kanalinjektion aufgeladen und mittels eines starken elektrischen Potentials zwischen Steuergate und einem Diffusionsgebiet entladen wird.

Die Drainansteuerung 220 wird für die i-te Spalte ($i = 1$ bis n) durch einen Transistor 210_i und einen dazu parallelgeschalteten Transistor 209_i gebildet. Der Transistor 210_i ist stets durchgeschaltet und so dimensioniert, daß durch ihn stets ein kleiner Strom fließt, der zum Le-

35-

VPA

78 P 1110 BRD

sen oder Kontrolllesen ausreicht, der jedoch nicht zum Programmieren einer Zelle ausreicht. Ein UND-Glied 208_i steuert mit seinem Ausgang 211_i das Gate des Transistors 209_i , so daß der Transistor 209_i Strom führt, der den Programmierstrom für eine programmierende Zelle liefert, wenn
 5 sowohl ein Dateneingang in der i-ten Zeile (D_{Ei}) erfolgt, d.h. der Eingang 213_i somit eine "1" aufweist und ein Schreibimpuls erfolgt, d.h. T_S legt ebenfalls eine "1" an den Eingang 212. Die Drainspannung der i-ten Spalte
 10 beträgt, wenn vom Widerstand des Transistors 209_i abgesehen wird, $U_{Di} \approx U_D \approx 17$ V. Bei allen anderen möglichen Speichervorgängen, z.B. in den Schreibimpulspausen, während der gesamten Löschdauer und während der Auslese-
 15 dauer, führt der Transistor 209_i keinen Strom, so daß kein Programmierstrom in den Drainleitungen der i-ten Spalte fließen kann.

Die Source-Ansteuerung 250 für eine Split-Gate-Speicherzelle, die mit Kanalinjektion aufgeladen und mittels
 20 eines starken elektrischen Feldes zwischen Steuergate und einem Diffusionsgebiet entladen wird, ist für alle Sourceleitungen gemeinsam. Sie besteht aus einem Widerstand 256, dessen einer Anschluß mit dem Drain eines Transistors 258 verbunden ist, während der Sourcean-
 25 schluß 261 des Transistors 258 auf Masse liegt und der freie Anschluß 255 des Widerstandes 256 ein Potential $U_{SS}=25$ bis 40 V aufweist. Das Gate des Transistors 258 wird über einen Inverter 259 während der Dauer der
 Löschimpulse T_L angesteuert. Der Transistor 258 ist so-
 30 mit während der Dauer eines jeden Löschimpulses gesperrt. Am Punkte 257, an dem die Source-Spannung U_S abgegriffen wird, ergibt sich bei gesperrtem Transistor 258 somit eine Spannung $U_S \approx U_{SS} = 25$ bis 40 V. Diese relativ hohe positive Sourcespannung wird auch nur während der Lösch-
 35 impulse für das in Fig. 4 gewählte Beispiel einer Spei-

cherzelle benötigt. Bei der der Fig. 4 zugrunde gelegten Split-Gate-Speicherzelle wird während der Löschimpulse eine hohe positive Spannung am Source angelegt, während das Steuergate z.Zt. eine Spannung von 0 V aufweist. Zu allen
 5 übrigen Zeiten außerhalb der Löschimpulse ist der Transistor 258 leitend, das Potential am Punkt 257, und zugleich die Source-Spannung U_S , beträgt $U_S - 0$ V.

Fig. 5 stellt eine Source- und Drainansteuerung für
 10 einen erfindungsgemäßen Speicher dar, der aus Speicherzellen aufgebaut ist, die durch Anlegen von hohen elektrischen Feldern zwischen Steuergate und einem Diffusionsgebiet aufgeladen und entladen werden. Die Gateansteuerung erfolgt analog der Gateansteuerung nach
 15 Fig. 4.

Die Drainspannungen U_{Di} ($i = 1$ bis n) werden über ständig durchgeschaltete Transistoren 270_i mit einer Versorgungsspannung V_{DD} verbunden.
 20

Da in dem betrachteten Ausführungsbeispiel zwischen Kanalbereich und Gate über den Sourceanschluß gelöscht und programmiert wird, ist die Sourceansteuerung entsprechend aufwendig. Beim Löschvorgang ist $T_S = 0$, weshalb bei der
 25 Sourceansteuerung der i -ten Spalte der Eingang 286_i des UND-Gliedes 285_i eine "0" aufweist. Das UND-Glied 285_i weist somit am Ausgang und gleichzeitig am Eingang 284_i des NOR-Gliedes 281_i eine "0" auf. Der zweite Eingang 283_i weist während der Dauer der Löschimpulse eine "1" und sonst eine "0" auf. Damit liegt während der Dauer
 30 der Löschimpulse T_L am Ausgang 282_i des NOR-Gliedes 281_i eine "0" an, weshalb der Transistor 271_i während der Dauer der Löschimpulse gesperrt ist, während dieser in den Löschimpulspausen durchgeschaltet ist. Während der

37-37-

VPA

78 P 1110 BRD

- Löschimpulsdauer T_S liegt somit die Spannung des Punktes 290 über den Widerstand 277_i an den Sourceleitungen als Source-Spannung U_{Si} an. Da $T_S = 0$ gilt, ist der Transistor 272 gesperrt und da zugleich $T_L = 0$ gilt, ist auch der
- 5 Transistor 273 gesperrt. Am Punkt 290 liegt somit die Spannung $U_p = 20$ bis 40 V an. Während der Löschimpulspausen liegt hingegen, infolge des durchgeschalteten Transistors 271_i , eine Spannung U_{Si} von ungefähr gleich 0 V an.
- 10 Beim Schreibvorgang wird zunächst der Zustand während der Dauer von Schreibimpulsen für eine Spalte i mit einer Zelle eines angewählten Wortes betrachtet, in die eine Information eingeschrieben werden soll, d.h.
- $$T_S = 1; D_{Ei} = 1.$$
- 15 Über den Inverter 289_i erhält der Eingang 287_i des UND-Gliedes 285_i eine "0". Der Ausgang 284_i des UND-Gliedes 285_i gibt deshalb eine "0" an einen Eingang des NOR-Gliedes 281_i ab. Der zweite Eingang 283_i führt ebenfalls eine "0", da $T_L = 0$ gilt. Der Ausgang 282_i des NOR-Glie-
- 20 des 281_i führt somit eine "1" und schaltet den Transistor 271_i während der Dauer der Schreibimpulse T_S durch. Die Sourcespannungen U_{Si} , in deren Spalte eine Zelle eingeschrieben werden soll, betragen somit $U_{Si} \approx 0$ V.
- 25 Auch während der Dauer der Schreibimpulspausen ist der Transistor 271_i durchgeschaltet, da in diesem Falle lediglich beide Eingänge des UND-Gliedes 285_i eine "0" aufweisen, wodurch das Ausgangssignal von 285_i nicht geändert wird. Es gilt deshalb auch $U_{Si} \approx 0$ V.
- 30 Bei einer Spalte k , bei der in die angewählte Zelle keine Information eingeschrieben werden soll, gilt $D_{Ek} = 0$. Wegen des Inverters 289_k liegt am Eingang 287_k somit stets eine "1" an. Am zweiten Eingang 286_k des UND-Glie-
- 35 des 285_k liegt jeweils während der Dauer eines Schreib-

impulses ebenfalls eine "1" an. Während der übrigen Zeiten liegt dort eine "0" an. Deshalb liegt auch während der Dauer der Schreibimpulse am Eingang 284_k des ODER-Gliedes 281_k stets eine "1" und sonst eine "0" an. Da

5 während der gesamten Schreibphase $T_L = 0$ ist, führt der zweite Eingang 283_k des ODER-Gliedes 281_k während der Schreibphase stets eine "0". In der Schreibphase gibt somit der Ausgang 282_k des NOR-Gliedes 281_k während der Schreibimpulspausen eine "1" ab, d.h. der Transistor 271_k

10 ist durchgeschaltet und das heißt wiederum, die Source-Spannung $U_{Sk} = 0$ V. Während der Dauer der Schreibimpulse gibt hingegen das NOR-Glied 281_k eine "0" am Ausgang 282_k ab, weshalb der Transistor 271_k gesperrt ist. Die Source-Spannung U_{Sk} ist in diesem Fall über den Widerstand 277_k

15 auf dem Potential des Punktes 290. Während der Dauer der Schreibimpulse, d.h. $T_S \neq 0$ ist der Transistor 272 durchgeschaltet, während der Transistor 273 infolge des zwischen-geschalteten NOR-Gliedes 276 gesperrt ist. Die Spannung des Punktes 290 beträgt, da die Widerstände 274 und 275

20 gleich groß sind, $U_p/2$; mit $U_p \approx 20$ V bis 40 V. Damit beträgt auch die Source-Spannung U_{Sk} für eine Spalte K mit einer angewählten Zelle, in die keine Information eingeschrieben werden soll, während der Dauer der Schreibimpulse $U_{Sk} \approx U_p/2$, wenn der Spannungsabfall am Widerstand

25 277_k vernachlässigt wird.

Während der Dauer eines Auslesevorganges sind die Dateneingänge 0, deshalb liegt über die Inverter 289_i ($i = 1$ bis n) eine "1" am Eingang 287_i und wegen $T_S = 0$ eine

30 "0" am Eingang 286_i des UND-Gliedes 285_i an, weshalb der Ausgang dieses UND-Gliedes 285_i eine "0" an den Eingang 284_i legt. Da gleichzeitig auch nicht gelöscht wird, liegt am zweiten Eingang 283_i des NOR-Gliedes 281_i ebenfalls eine "0" an, weshalb der Ausgang 282_i des NOR-Gliedes

35 des 281_i eine "1" auf das Gate des Transistors 271_i legt.

Der Transistor 271_i ist somit durchgeschaltet. Die Source-Spannung beträgt somit während der Auslesephase $U_{Si} \approx 0$ V.

Die bitweise geführten Drainleitungen liegen über die durchgeschalteten Transistoren 270_i ($i = 1$ bis n) alle
 5 stets auf dem gleichen Potential V_{DD} .

Abschließend wird aufgezeigt, daß die in Fig. 4 und 5 beschriebenen Gate-, Source- und Drainansteuerungen für die jeweils verwendeten Fälle die entsprechenden Löschi-, bzw.
 10 Schreib- bzw. Lesebedingungen liefern. Gelöscht wird bei beiden Zellentypen nach Fig. 4 und Fig. 5 jeweils dadurch, daß am Source eine hohe positive und am Gate eine Spannung von 0 V angelegt wird. Während der Dauer der Löschimpulse liegt nach Fig. 4 $U_{SS} \approx 25$ bis 40 V als Spannung an den
 15 einzelnen bitweise geschalteten Sourceleitungen an. Im Falle von Fig. 5 liegt an den bitweise geschalteten Sourceleitungen jeweils die Spannung $U_{Si} \approx U_p = 20$ V bis 40 V ($i = 1$ bis n) an. An der Gateleitung eines angewählten Wortes liegt während der Dauer der Löschimpulse
 20 eine Spannung von $U_{Gi} \approx 0$ V an, während an den Gateleitungen der nicht angewählten Worte eine hohe positive Spannung von $U_{Gk} \approx 25$ V anliegt. Damit wird während der Löschimpulse nur das angewählte Wort gelöscht, während die Nachbarworte nicht beeinflußt werden. In den
 25 Löschimpulspausen liegen alle Sourceleitungen der Fig. 4 und 5 auf einer Spannung von ungefähr $U_{Si} \approx 0$ V. An der Gateleitung der angewählten Worte liegt eine relativ kleine positive Lesespannung U_{GL} an, die so klein ist, daß keine Information eingeschrieben werden kann. Die
 30 Gateleitungen der nicht angewählten Worte liegen ebenfalls auf einem Potential von ungefähr $U_{Gk} \approx 0$ V. Die angewählten Worte werden damit während der Dauer der Löschimpulse gelöscht und Nachbarwortstörungen sind sicher ausgeschaltet.

Während der Dauer der Schreibimpulse liegt an der Gateleitung eines angewählten Wortes eine hohe positive Spannung, z.B. 25 V an, während an den Gateleitungen der nicht angewählten Worte eine Spannung von ungefähr 0 V anliegt.

Bei Zellen der Fig. 4 fließt gleichzeitig in den Spalten, in denen eine einzuschreibende Zelle liegt, ein hoher Kanalstrom, der zur Programmierung der Zelle ausreicht, während in denjenigen Spalten, deren angewählte Zelle keine Information erhalten soll, nur ein sehr geringer Kanalstrom fließt, der nur als Lesestrom verwendet werden kann, jedoch zum Aufladen einer Zelle nicht ausreicht. In die nicht angewählten Nachbarworte wird bei denjenigen Bits mit hohem Kanalstrom nichts eingeschrieben, da gleichzeitig die Gatespannung an den nicht angewählten Worten $U_{Gk} \approx 0$ V beträgt. Während der Schreibimpulspausen beträgt die Gatespannung nicht angewählter Worte ungefähr 0 V, während die Gatespannung eines angewählten Wortes eine geringe positive Kontrolllesespannung U_{GS} aufweist. Während der Schreibimpulspausen ist ebenfalls der hohe Kanalstrom ausgeschaltet. Es fließt lediglich ein sehr kleiner Kanalstrom, der zwar zum Lesen bzw. Kontrolllesen ausreicht, jedoch nicht zum Einschreiben einer Information ausreicht. Wegen der gleichzeitig unterschiedlichen Gatespannungen eines angewählten Wortes gegenüber den Gatespannungen der nicht angewählten Worte wird auch tatsächlich nur an den Zellen des angewählten Wortes gelesen.

30

Die Zellen eines Speichers nach Fig. 5 werden durch Anlegen einer hohen Spannung zwischen dem Steuergate und einem Diffusionsgebiet, z.B. dem Source, aufgeladen. Während eines Schreibimpulses liegt an der Gateleitung eines angewählten Wortes eine hohe positive Spannung von

35

- ungefähr 25 V bis 40 V an, während an den Gateleitungen der nicht angewählten Worte eine sehr geringe positive Spannung liegt, die zum Einschreiben einer Information in die Zelle nicht ausreicht und z.B. der Kontrollese-
- 5 spannung beim Schreiben U_{GL} entspricht. Gleichzeitig liegt in denjenigen Spalten, in denen eine Information in die angewählte Zelle eingetragen werden soll, eine Spannung von ungefähr 0 V am Source an. Alle übrigen Sourceleitungen, in denen keine einzuschreibende Zelle liegt, weisen
- 10 gleichzeitig eine positive Spannung von $1/2 U_p$ auf. Die unterschiedlichen Gatespannungen zwischen angewählten Worten und nicht angewählten Worten stellen sicher, daß in der angewählten Zelle eine Information eingeschrieben wird, während in Nachbarzellen des gleichen Bits
- 15 keine Information eingeschrieben wird. Bei Bits, in denen keine Information eingeschrieben werden soll, ist das Potentialgefälle zwischen dem Gate und dem Source gerade so bemessen, daß es zum Einschreiben einer Information nicht ausreicht, z.B. $1/2 U_p$ beträgt. Dadurch
- 20 wird sichergestellt, daß in allen Zellen eines Bits, deren Sourceleitungen mit $1/2 U_p$ beaufschlagt ist, tatsächlich keine Information eingeschrieben wird.

- Während der Schreibimpulspausen liegt an den angewählten
- 25 Gates die Kontrollesespannung beim Schreiben U_{GS} an, die einer kleinen positiven Spannung entspricht. An allen Nachbargateleitungen liegt eine Spannung von ungefähr 0 V an. An allen Sourceleitungen liegt gleichzeitig eine Spannung von 0 V an und es fließt zwischen Source und
- 30 Drain ein geringer Lesestrom. Damit ist sichergestellt, daß nur an den Zellen des angewählten Wortes kontrollgelesen wird.

- Beim Auslesen liegt an dem Gate des angewählten Wortes
- 35 die Auslesespannung U_{GR} an. Die Spannung nicht angewählter Worte beträgt während des Auslesens 0 V.

- Für Zellen, die mittels hoher elektrischer Felder zwischen Steuergate und einem Diffusionsgebiet, beispielsweise dem Source, aufgeladen und entladen werden, kann eine Sourceansteuerung, ähnlich wie in Fig. 5 dargestellt, entwickelt werden, die gewährleistet, daß das Potentialgefälle zwischen Steuergate und Source von nicht angewählten Zellen nur ein Drittel des Potentialgefälles beträgt, das zum Einschreiben von angewählten Zellen zwischen Steuergate und Source angelegt wird. Eine solche
- 5 Modifikation der in Fig. 5 dargestellten Sourceansteuerung ließe sich durch eine geeignete Dimensionierung und Schaltung der Widerstände 274 und 275 aus Fig. 5 erreichen. Zusätzlich müßten die Elemente 520 und 510 der
- 10 Gateansteuerung abgeändert werden. Eine derartige Modifikation ließe sich aus Fig. 5 unter Anwendung der Ansteuerbedingungen, wie sie in der Deutschen Anmeldung
- 15 P 27 43 422.6 beschrieben sind, ableiten.

- Erfindungsgemäße Speicher sind für Abstimmspeicher in
- 20 Fernsehgeräten für Nummernspeicher in Fernsprechvermittlungsanlagen sowie für Programmspeicher von Kleinrechnern anwendbar.

- 11 Patentansprüche
Figuren

Zusammenfassung

Ein wortweise elektrisch unprogrammierbarer, nicht-
flüchtiger Speicher mit matrixförmig angeordneten Spei-
5 cherzellen ist derart mit einer Ansteuerung versehen,
daß für jede Speicherzeile variable Löscho- und Schreib-
dauern vorgesehen sind, deren Ende durch das Erreichen
eines vorgegebenen Löscho- bzw. Schreibzustandes einer oder
mehrerer Speicherzellen aus der zu löschenden bzw. zu
10 schreibenden Speicherzeile angezeigt wird.

Durch diese Maßnahme wird ein äußeres Zeitglied einge-
spart, kürzere Programmierzeiten, eine geringere Ab-
hängigkeit von Prozeßtoleranzen, niedrigere Löscho-
15 Schreibspannungen und geringere Nachbarwortstörungen
sowie eine höhere Zahl von Schreib-Löschozyklen erreicht.

- 44 -
Leerseite

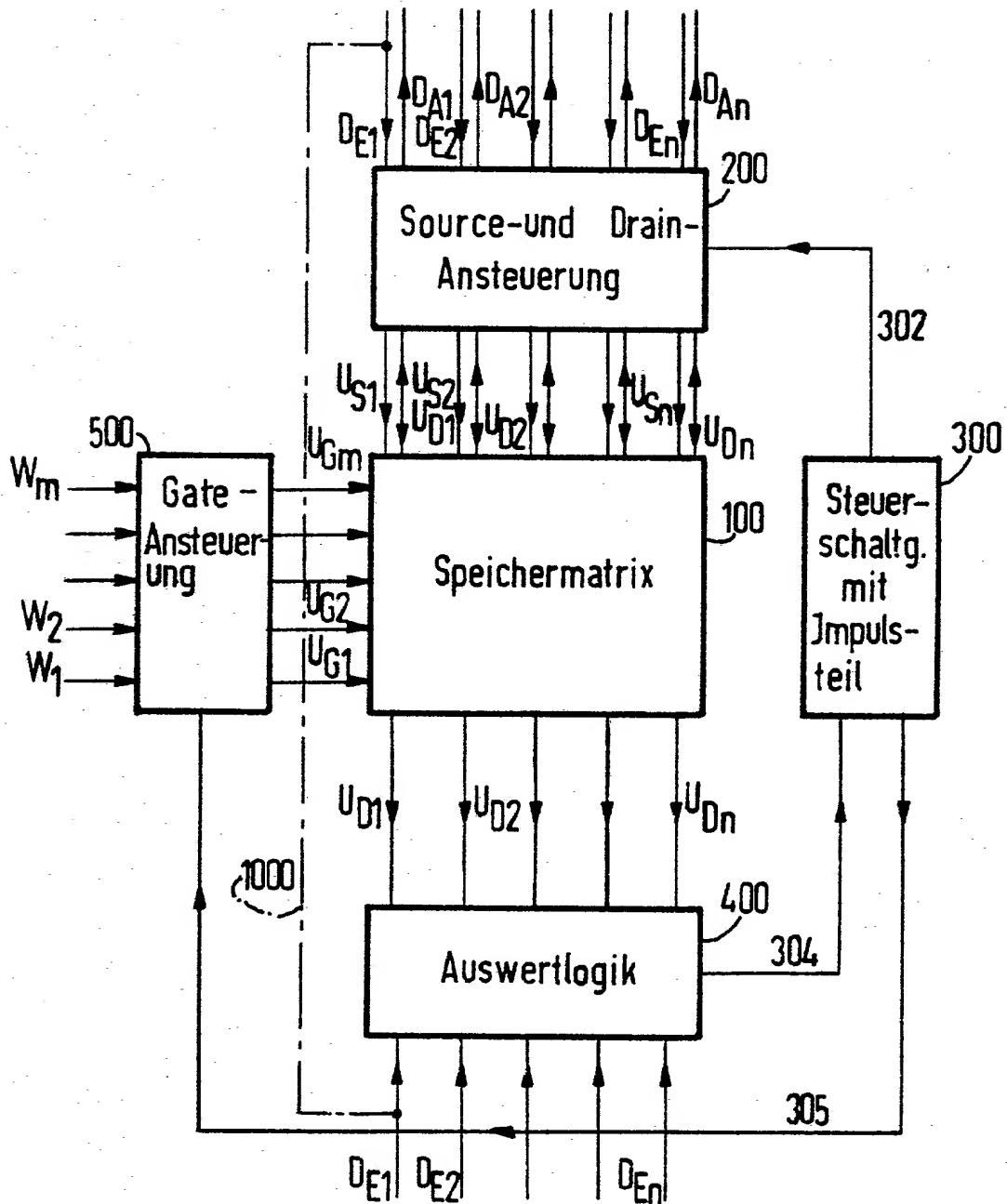
Nummer:
Int. Cl. 2:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

28 28 855
G 11 C 7/00
30. Juni 1978
3. Januar 1980

- 49 -
2828855

FIG 1

78 P 1110 BRD/5



909881/0488

FIG 2

2828855

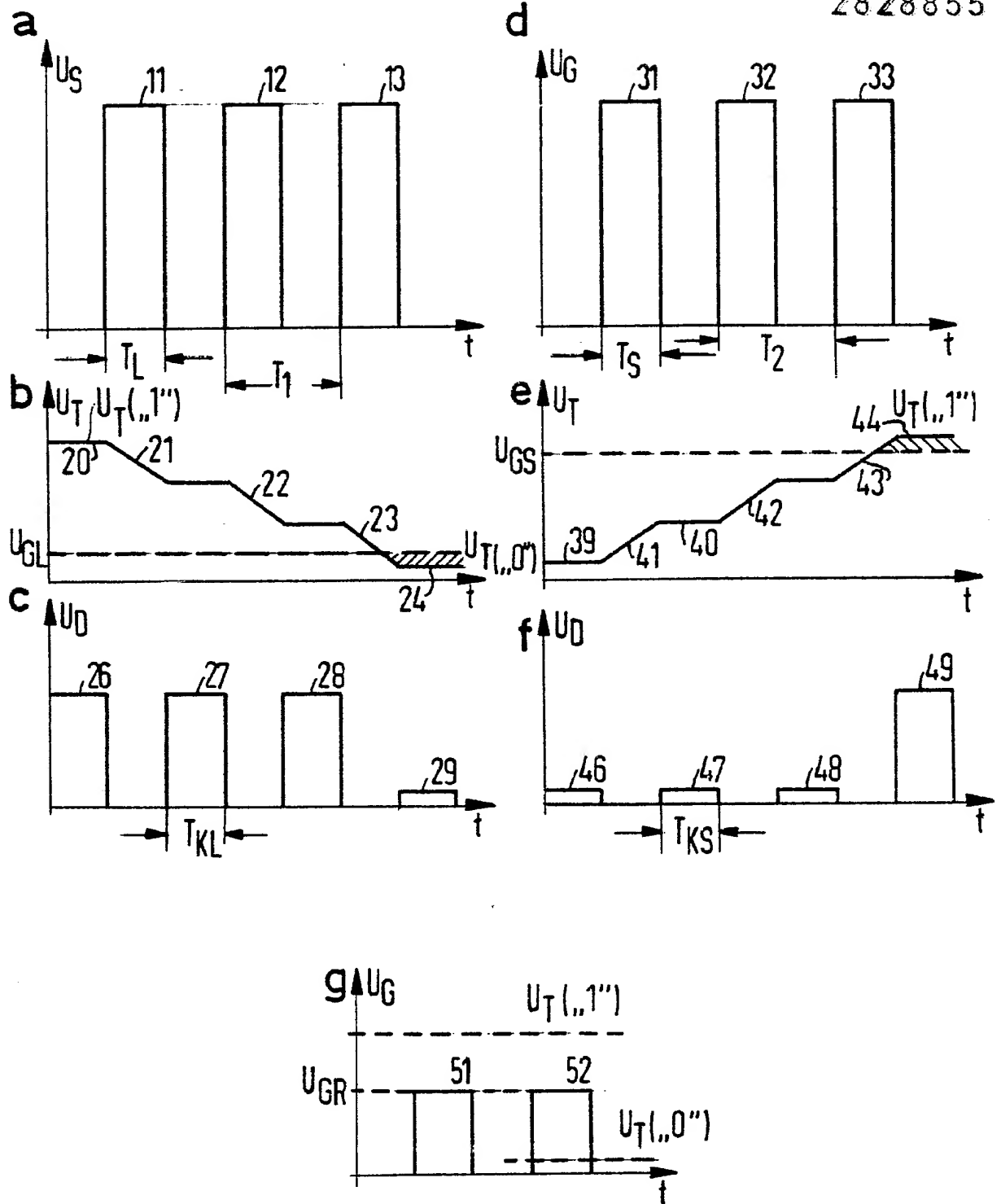


FIG 3

78 P 1 1 1 0 BRD 3/5

2828855

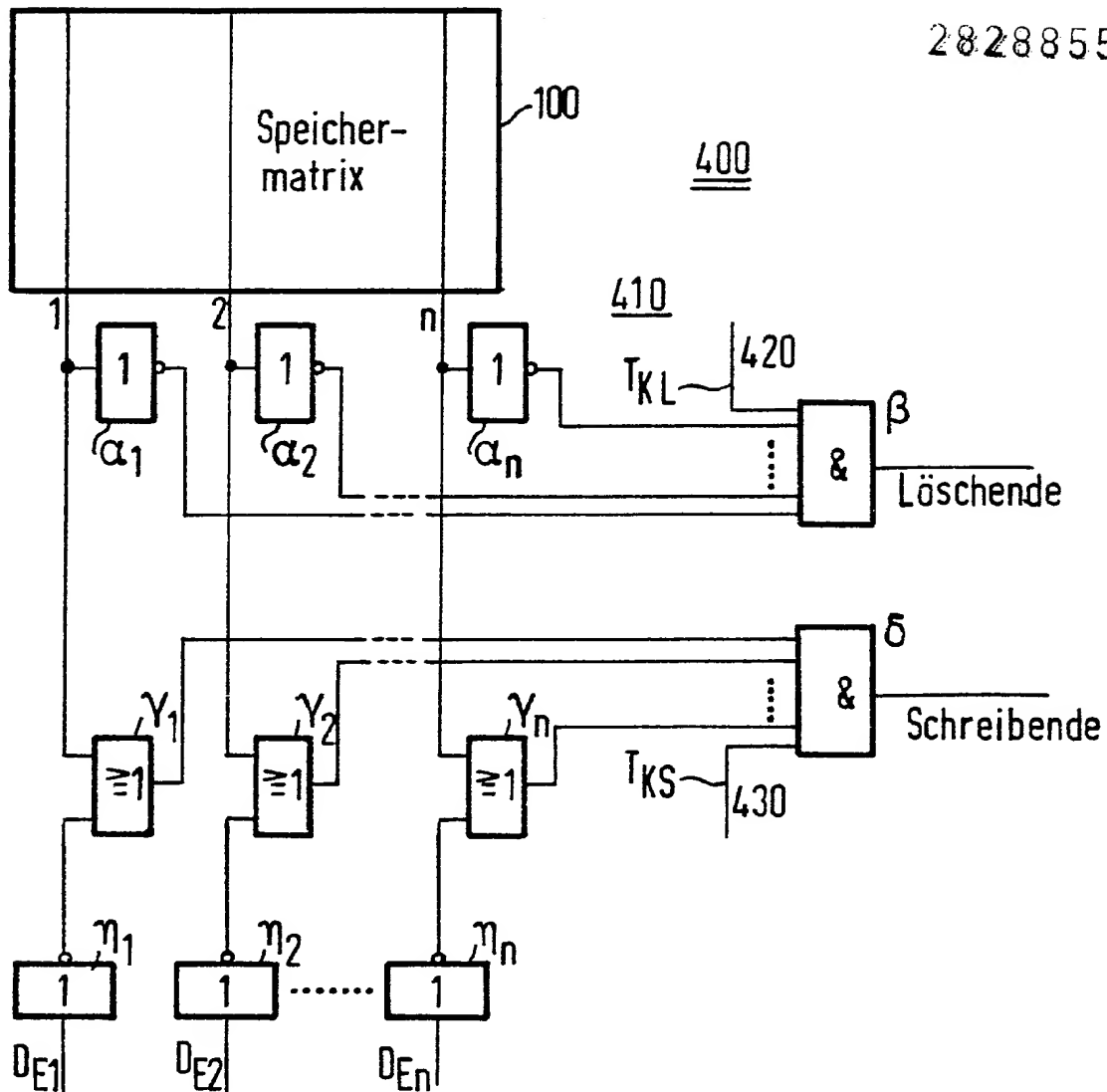
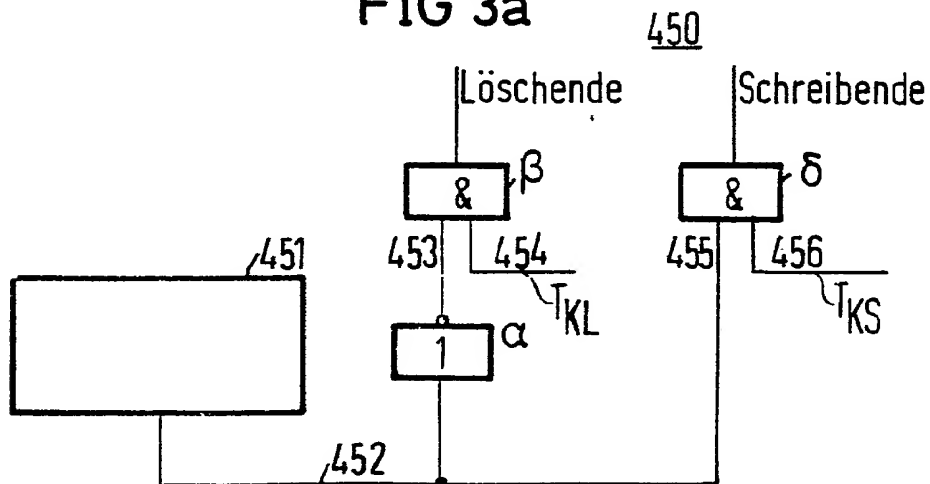


FIG 3a



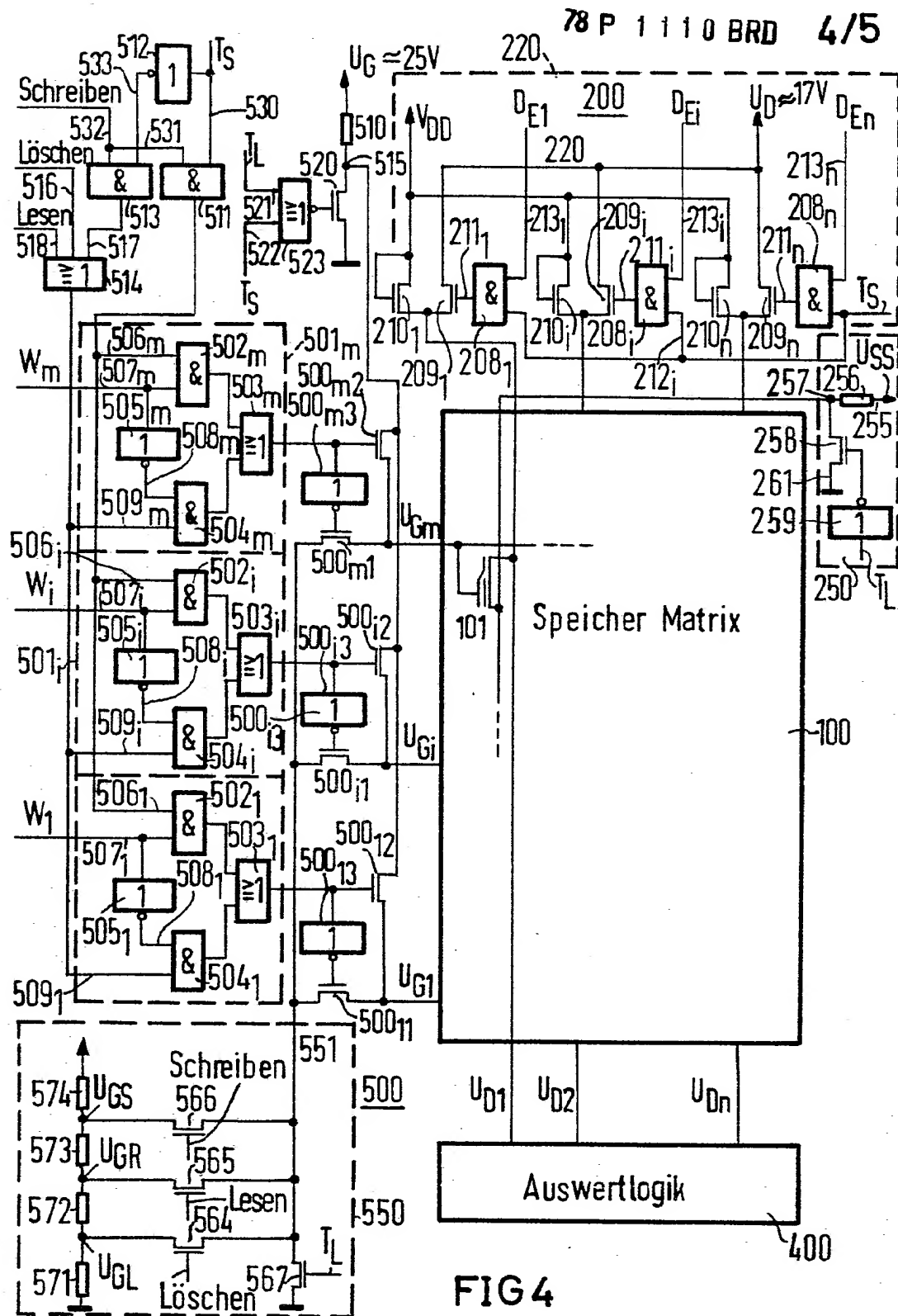


FIG 4

FIG 5

78 P 1 1 1 0 BRD 5/5

2828855

